概述

TX4132N是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC，芯片内置60V/5A功率MOS，最高输入电压55V。

TX4132N具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出，输出电流可达3A以上。

TX4132N同时支持输出恒压与输出恒流。

TX4132N采用固定频率的PWM 控制方式，典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。

TX4132N内部集成软启动以及过温保护电路，输出短路保护，限流保护等功能，提高系统可靠性。

TX4132N采用ESOP8封装，散热片内置接VIN脚。

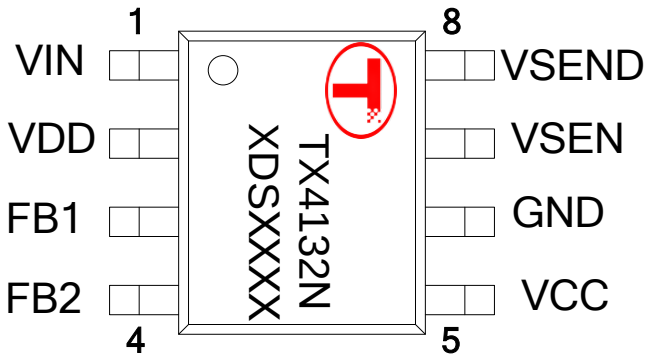
特点

- 宽输入电压范围：8V~55V
- 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
- 支持输出恒压恒流
- 支持输出 5V/3A,12V/3A
- 高效率：可高达 96%
- 工作频率：140KHz
- 低待机功耗
- 内置过温保护、输出短路保护
- 内置软启动

应用

- 追踪器
- 恒压源
- 电动汽车、电动自行车、电瓶车
- 扭扭车、卡车

封装及管脚分配



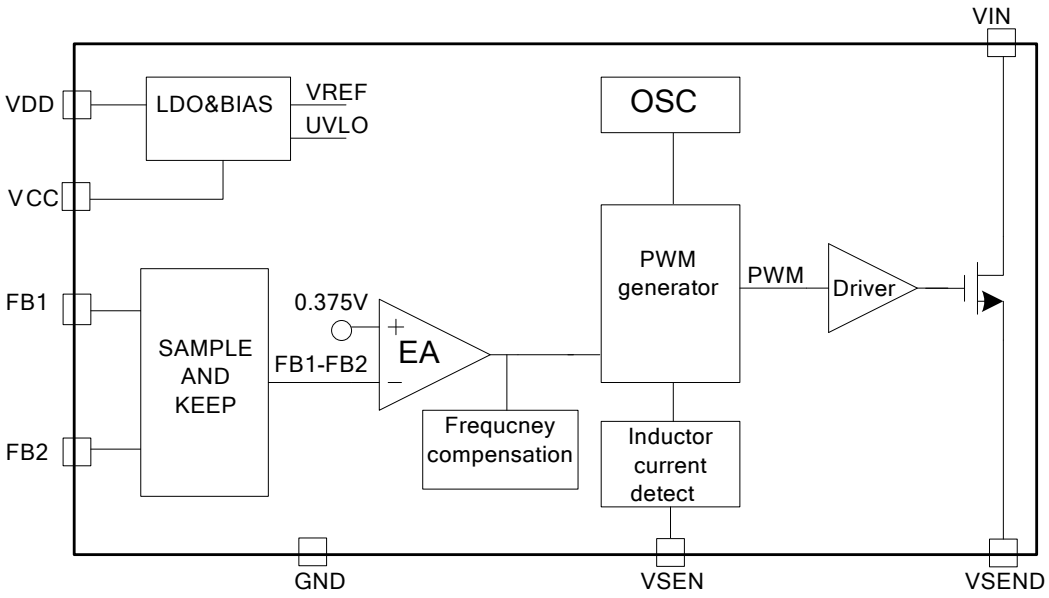
ESOP8

（散热片内置接 VIN 脚）

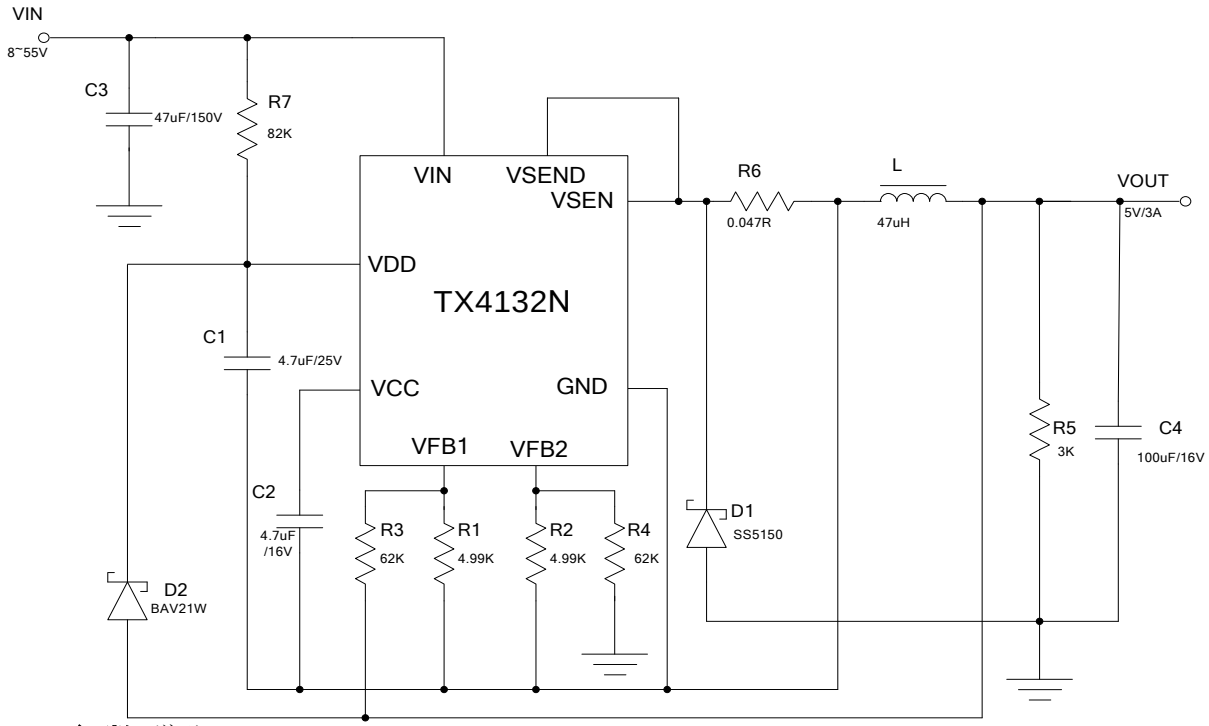
管脚定义

管脚号	管脚名	描述
1	VIN	内置 MOS 漏极，接输入电源
2	VDD	芯片电源
3	FB1	输出反馈电压正端采样
4	FB2	输出反馈电压负端采样
5	VCC	内部 5.5V LDO 输出，接电容。
6	GND	芯片地
7	VSEN	电感电流检测脚
8	VSEND	内置 MOS 源极
-	散热片	内置接 VIN 脚

内部电路方框图



典型应用电路图



极限参数（注 1）

符 号	描述	参数范围	单位
VIN	VIN 端最大电压	60	V
VDD	VDD 端最大电压	20	V
Vmax	FB1、FB2、VCC、VSEN、VSEND 脚电压	-0.3~6	V
P_{ESOP8}	ESOP8 封装最大功耗	1	W
T_A	工作环境温度范围	-40~85	℃
T_J	工作结温范围	-40~125	℃
T_{STG}	存储温度范围	-40~125	℃
T_{SD}	焊接温度范围(时间小于 30 秒)	240	℃
V_{ESD}	静电耐压值（人体模型）	2000	V

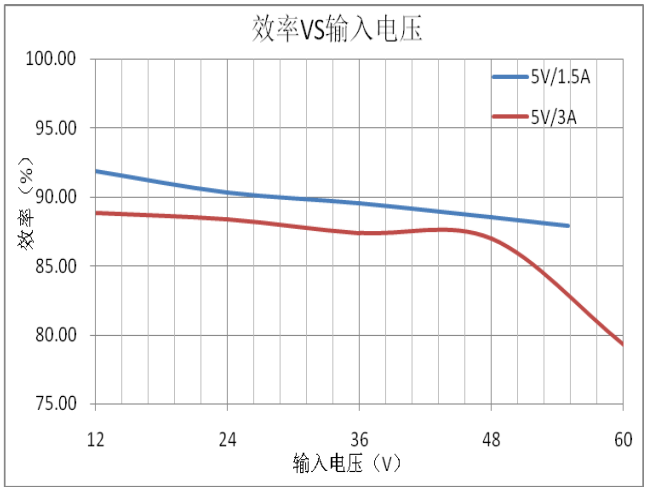
注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

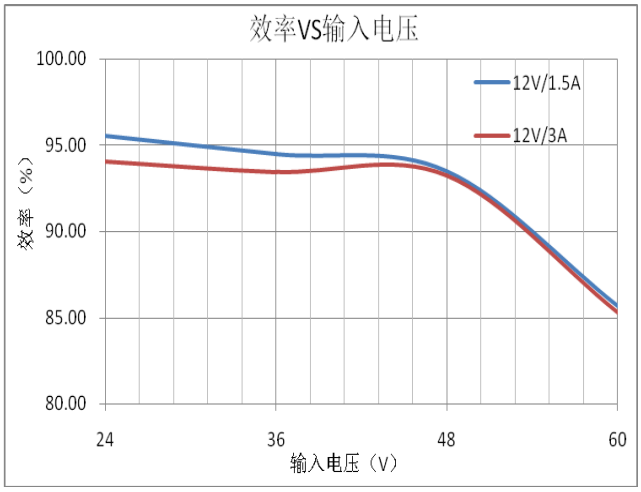
电特性(除非特别说明，V_{DD}=12V，T_A=25℃)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压						
VDD 钳位电压	V_{DD}	IVDD<10mA		20		V
欠压保护开启	VDD_ON	V_{DD}上升		4.75		V
欠压保护关闭	VDD_OFF	V_{DD}下降		3.35		V
电源电流						
工作电流	I_{OP}	DRV负载 1nF电容		1		mA
启动电流	$I_{STARTUP}$	VDD=5V		40	100	uA
功率管电流限流						
过流保护阈值	VCS_LMT			276		mV
输出电压采样						
VSEN 电压降	VCS		130	138	145	mV
FB1，FB2 电压差	VFB		360	375	390	mV
开关频率						
开关频率	FS			140		KHz
内置 MOS						
MOS 管耐压	VDS		60			V
MOS 管导通内阻	RDSON	VGS=5V		70		mΩ
过温保护						
过温保护	OTP_TH			155		℃
过温保护迟滞	OTP_HYS			20		℃
LDO						
VCC 电压	VCC			5.5		V

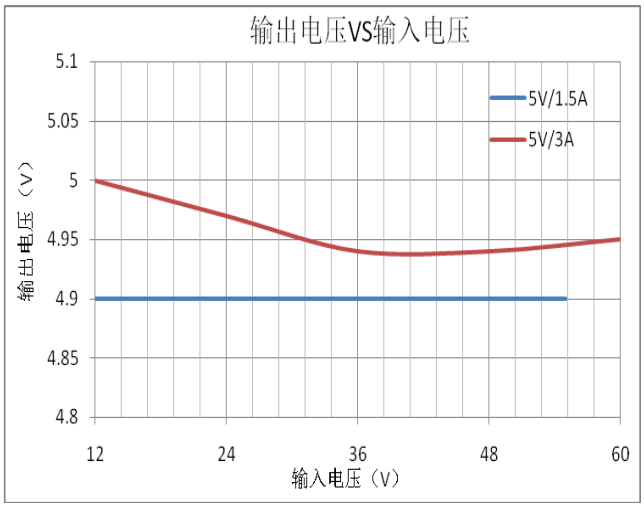
典型应用特性曲线

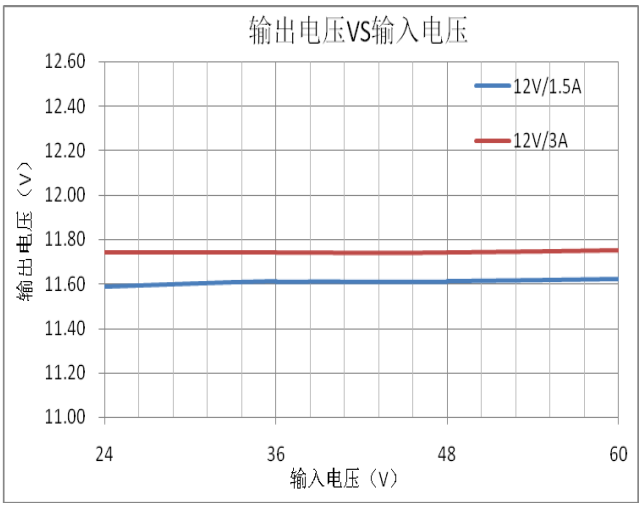
（1）输出 5V/12V,1.5A/3A 效率与输入电压特性曲线





（2）输出 5V/12V,1.5A/3A 输出与输入电压特性曲线





应用指南

概述

TX4132N是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置 60V/5A功率MOS。

TX4132N采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式，具有低待机功耗、快的响应速度，以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

TX4132N 同时支持输出恒压与输出恒流。TX4132N 内部集成软启动以及过温保护电路，输出短路保护，限流保护等功能，提高系统可靠性。

电感峰值电流设置

电感峰值电流通过连接于VSP与GND之间的电阻设置（参见图 1 应用电路图）：

$$IOUT_MAX = \frac{VCS}{R6}$$

VCS 典型值为 138mV。例如 R6=45.5mΩ，则输出限流为 3.033A。

输出电压设置

通过连接于FB1，FB2 脚的分压电阻R1，R3，R2，R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2，R3=R4。

$$VOUT = \frac{R3 + R1}{R1} * VFB$$

其中 VFB 典型值为 375mV。

电感取值

电感典型取值在 33uH到 100uH之间，大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR，ESR过大会降低效率。

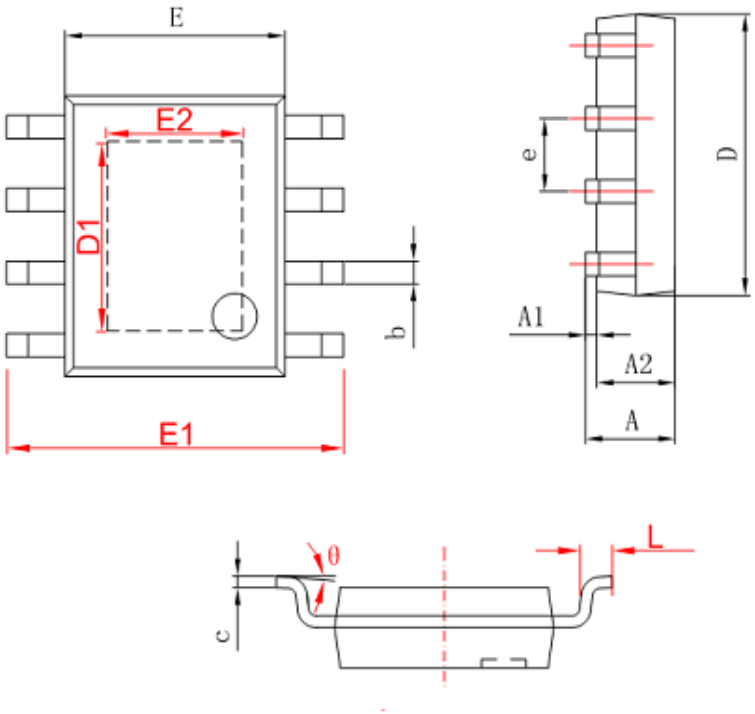
过温保护

芯片内部集成过温保护，当芯片温度高过温保护点（典型值为 155 度）时，系统会关断功率管，从而限制输入功率，增强系统可靠性。

封装信息

ESOP8 封装参数

- **SOP-8/PP**



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°